

# آرایه خطی از آتن پلاسما با کاربرد فضایی

فاطمه صادقی کیا<sup>۱\*</sup>، فرج حجت کاشانی<sup>۲</sup>، جلیل راشد محصل<sup>۳</sup> و سید جواد قیومه بزرگی<sup>۴</sup>

۱، ۲ و ۴- دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران

۳- دانشکده مهندسی برق، دانشگاه تهران

\*تهران، نارمک، فرجام

sadeghikia@ee.iust.ac.ir

آرایه دوتایی از المان‌های تک‌قطبی پلاسمایی با تحریک موج سطحی با روش عددی FDTD مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌گیرد. با تغییر توان تحریک المان‌های پلاسمایی، آرایه‌ای حاصل می‌شود که می‌تواند برای فرکانس‌های کاری مختلف مجددًا تغییر شکل دهد. المان‌های پلاسمایی با توان RF در فرکانس ۵۰۰ مگاهرتز و فشار گاز آرگون ۰/۴ میلی‌بار از طریق تقسیم‌کننده توان هم‌فاز و همدامنه تعذیه می‌شوند. نتایج نشان می‌دهند که تغییرات توان تحریک می‌تواند فرکانس تشدید آرایه را بین ۱۲۰ مگاهرتز تا ۵۰ مگاهرتز تغییر دهد و در این حالت در فرکانس تشدید جدید مقدار بهره و جهت‌داری آرایه در فرکانس تشدید جدید تقریباً بدون تغییر باقی بماند. با توجه به اهمیت مقدار راندمان تشعشعی یک آتن، راندمان تشعشعی آرایه در محدوده حداقل و حداًکثر توان تحریک مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. حداًکثر مقدار راندمان تشعشعی به آرایه‌ای اختصاص دارد که طراحی اولیه بر مبنای آن انجام گرفته و فاصله میان المان‌ها ربع طول موج است. حال آن که در سایر مقادیر، در ناحیه فرکانس تشدیدشان، مقدار راندمان تشعشعی تقریباً یکسان است. با استفاده از این ساختار در وسایل نقلیه هوایی و فضایی می‌توان از یک آرایه برای هم‌چوایی چند منظور مختلف و در چند فرکانس غیرهمسان استفاده کرد تا از تداخل ناشی از هم‌چوایی آتن‌ها اجتناب کرد.

**واژه‌های کلیدی:** آتن پلاسما، امپدانس ورودی، امپدانس متقابل، بهره، جهت‌داری و راندمان

$\mu_0$

قابلیت نفوذپذیری مغناطیسی فضای آزاد

$\vec{J}$

چگالی جریان پلاسما

$h$

طول آتن

$P_0$

توان RF تحریک

## مقدمه

با توجه به فضای محدود روی وسایل نقلیه هوایی و فضایی و نیز مطالبات روزافزون برای افزایش سیستم‌های مخابراتی در این سامانه‌ها، عملکرد این سیستم‌ها به دلیل ایجاد اثر تداخلی بین آتن‌های هم‌چوای کاهش می‌یابد. علاوه بر این، افزایش تعداد آتن‌ها روی سیستم سبب افزایش وزن و درگ در این سیستم‌ها می‌شود [۱]. بهترین روش برای حل چنین مشکلاتی کاهش تعداد آتن‌های روی بدنه است تا بتوان از یک آتن برای چند منظور استفاده کرد. انگیزه استفاده چندمنظوره

## علائم و اختصارات

فرکانس تشدید پلاسما (Hz)

چگالی الکترون

فرکانس برخورد (هرتز)

جرم الکترون (کیلوگرم)

قابلیت گذردهی فضای آزاد (فاراد بر متر)

میدان‌های الکتریکی، مغناطیسی

۱. دکتری (نویسنده مخاطب)

۲. استاد

۳. استاد

۴. پژوهشگر

کاهش سطح مقطع راداری آتن در موقع لزوم به اندازه سطح مقطع راداری یک محفظه دیالکتریک اشاره کرد [۵]. آتن پلاسما، در صورت طراحی دقیق و مناسب، می‌تواند در مدت کوتاهی، تا حد چند میلی ثانیه، خاموش و روشن شود [۱۰ و ۲]. پژوهشگران مختلفی به صورت آزمایشگاهی به بررسی آتن پلاسمای تکقطی با تحریک موج سطحی (SWD<sup>۳</sup>) پرداخته‌اند [۱۰-۱۲]. با توجه به آن که ابعاد مختلف فناوری آتن پلاسما هنوز به صورت جامع شناخته نشده است، و نیز با توجه به محدودیت‌هایی که ممکن است از نظر اقتصادی برای تست آزمایشگاهی این آتن وجود داشته باشد، مقرن به صرفه‌ترین راه برای شناخت آن استفاده از تحلیل‌های نرم‌افزاری است. با استفاده از این تحلیل‌ها می‌توان آتنی با مشخصات آتن پلاسمای تکقطی، با تغییر پژوهش‌های پیشین، مشخصات آتن پلاسمای تکقطی، با تغییر عوامل تحریک و نیز مشخصات فیزیکی محفظه حاوی پلاسما، بررسی شد [۱۳ و ۵]. این تحلیل‌ها نشان دادند که در صورت افزایش توان تحریک، به دلیل آن که طول ستون یونیزه شده افزایش می‌یابد، فرکانس تشدید آتن به سمت فرکانس‌های پایین‌تر منتقل می‌شود و این در حالی است که راندمان تشعشعی با افزایش قابلیت هدایت الکتریکی در همان ستون افزایش می‌یابد. در مرحله بعد، مشخصات آرایه تکقطی یاگی اوایل پلاسمایی، مورد تحلیل و شناسایی قرار گرفت [۱۳]. در ادامه این پژوهش‌ها، در این مقاله مشخصات تشعشعی آرایه خطی از المان‌های پلاسمایی تکقطی با تحریک هم‌فاز و همدامنه ارائه خواهد شد.

در این مجموعه، تحلیل عددی آرایه خطی پلاسمایی با تمرکز بر روی مشخصه امپدانسی، بهره و راندمان تشعشعی و جهت‌داری ارائه شده است. در بخش دوم از این مجموعه، روش عددی منتخب در تحلیل آتن پلاسما تشریح می‌شود و صحت این روش تحلیل ارزیابی می‌شود. در بخش سوم یک نمونه آرایه خطی پلاسمایی طراحی شده و نتایج تحلیل آن ارائه می‌شوند. در بخش پایانی، مقاله به صورت مختصر جمع‌بندی می‌شود.

## معرفی روابط

موج سطحی نوعی موج الکترومغناطیسی است که بین مرز مشترک چند محیط می‌تواند منتشر شود. تمرکز ما در این مجموعه بر روی مودهایی از موج سطحی است که تشعشع نمی‌کنند. برای تحلیل مکانیزم برخورد بین موج الکترومغناطیسی و پلاسما از روش انتگرال‌گیری مستقیم (DI) استفاده می‌شود [۱۴] و فرض می‌کنیم

از یک آتن با قابلیت شکل‌گیری مجدد می‌تواند ما را به سمت استفاده از فناوری نوظهور آتن پلاسما سوق دهد. با استفاده از این فناوری، آتن‌هایی که در زمان‌های مشخص مورد استفاده قرار نمی‌گیرند سیگنال‌های ناخواسته با توان بالا را به گیرندهای مجاورشان منتقل نمی‌کنند و بدین ترتیب، از یک سو ساختار الکترونیکی گیرندها ساده‌تر شده [۲] و از سوی دیگر قابلیت اطمینان سیستم‌ها، بهویژه در مقابل تهدیدات جنگ الکترونیک، افزایش می‌یابد.

عبارت آتن‌های پلاسما، به طور کلی به مجموعه‌ای از آتن‌ها اطلاق می‌شود که به نوعی از محیط یونیزه به عنوان هادی استفاده می‌کنند. پلاسمایی که به خوبی یونیزه شده باشد هادی خوبی محسوب می‌شود؛ بنابراین می‌توان آن را به عنوان خط انتقالی برای هدایت امواج یا سطح تشعشعی آتن در نظر گرفت. پژوهش در زمینه آتن پلاسما به صورت عمده از سال ۱۹۹۳ در آمریکا و استرالیا آغاز شد؛ لیکن در حال حاضر در بخش‌های زیادی از جهان دنبال می‌شود. با افزایش این پژوهش‌ها در آینده، به نظر می‌رسد کاربرد این فناوری در صنعت هواپما عمومیت بیشتری پیدا کند و موضع موجود در پیاده‌سازی آن مرتفع شود.

با توجه به آن که آتن‌های پلاسما بدلیل برخورداری از قابلیت‌های فشرده‌گی، تغییر سریع فرکانسی، سطح مقطع راداری محدود و بسیار کم، برقراری لینک ارتباطی با قابلیت اطمینان بالا و قابلیت شکل‌گیری سریع، می‌توانند جایگزین ارزشمندی برای فلزات در کاربردهای فعلی محسوب شوند، سرمایه‌گذاری‌های بسیاری در زمینه تحقیق و پژوهش روی مشخصات آن‌ها در کشورهای پیشرفته جهان انجام می‌گیرد. با استفاده از ستون پلاسما به عنوان آتن، طول آتن، با تغییر مشخصات فیزیکی تحریک پلاسما، به سرعت قابل تغییر است و به این ترتیب، با تنظیم سریع مشخصات فیزیکی آن، می‌توان آتنی برای فرکانس جدید طرح کرد. آزمایش‌ها و تحلیل‌ها نشان داده‌اند که چنین آتن‌هایی راندمان نسبتاً خوبی (بیش از ۵۰٪) دارند و می‌توانند نویز کمی در باندهای فرکانسی HF (۳-۳۰۰ مگاهرتز) و VHF (۳۰۰-۳۰۰۰ مگاهرتز) تولید کنند [۶-۲].

بررسی‌های مویسان<sup>۴</sup> نشان داد که محفظه حاوی پلاسما می‌تواند به طور مستقیم از یک انتهای به‌وسیله موج سطحی تحریک شود. نتایج این پژوهش‌ها اساس پژوهش‌های بسیاری در زمینه تحریک آتن پلاسما با موج سطحی قرار گرفت که از آن جمله می‌توان به پژوهش بورگ<sup>۵</sup> [۸ و ۹] اشاره کرد. استفاده از موج سطحی برای تحریک آتن پلاسما می‌تواند خواص شگفت‌آوری در آتن پلاسما به همراه داشته باشد که از آن جمله می‌توان به قابلیت

بررسی‌های آزمایشگاهی در اندازه‌گیری چگالی الکترون در طول ستون پلاسما با پرتوهای لانگمیر<sup>۹</sup> نشان داده است که چگالی الکترون، به صورت خطی از محل تحریک تا نقطه انتهای ستون کاهش می‌یابد و شبیه این تغییرات متناسب با فشار گاز درون محفظه است [۲۰ و ۲۱، ۱۹]. اندازه گیری‌های رینر<sup>۱۰</sup> [۲] نشان داده است، چنانچه آتن در راستای محور Z در نظر گرفته شده باشد، چگالی پلاسما در هر نقطه از آن برابر است با:

$$n(z, p) = n_{critical} + k v(h - z) \quad (5)$$

که در آن  $k$  و  $v$  در فشار ثابت برای گاز مشخص مقداری ثابت دارند و برای گاز آرگون در فشار  $\frac{1}{4}$  میلی‌بار،  $k = 5 \times 10^9$  متر مریع بر ثانیه و  $v = 5 \times 10^8$  هرتز هستند.  $h$  طول آتن است که با رابطه زیر بیان می‌شود:

$$h = \frac{n_0 L_0}{n_{critical}} - L_0 \quad (6)$$

و  $L_0 = \frac{n_{critical}}{k v}$  حداقل طولی است که با آن ستون پلاسما تبدیل به آتن می‌شود و می‌تواند ارسال و دریافت داشته باشد و  $n_0$  چگالی پلاسما در محل تحریک است و مقدار آن برابر خواهد بود با:

$$n_0 = A(p) \sqrt{P_0} \quad (7)$$

که  $P_0$  توان RF تحریک است و  $A(p)$  که مقدار آن در [۲] اندازه گیری شده است، در فشار ثابت مورد نظر  $\frac{1}{4}$  میلی‌بار برابر با خواهد بود.  $A(p) = 0.28 \times 10^{18} m^{-3} W^{1/2}$

چگالی نقطه انتهایی آتن است و مقدار آن برابر است با:

$$n_{critical} = \frac{4\pi^2 \epsilon_0 m_e}{e^2} f^2 (1 + \epsilon_d) \quad (8)$$

$f$  فرکانس تحریک و  $\epsilon_d$  خربی دی‌الکتریک ستون پلاسما است و بر اساس پژوهش‌های انجام گرفته در [۵] جنس محفوظه را کوارتز ( $\epsilon_d = 3.75$ ) در نظر گرفتیم.

## تشريح ساختار آتن پلاسما

در شکل (۱) ساختاری از آتن پلاسما با تحریک موج سطحی که شبیه‌سازی می‌شود نشان داده شده است. آتن پلاسما از یک محفظه کوارتز با شعاع ۱۲ میلی‌متر و طول ۱۲۰۰ میلی‌متر و ضخامت  $5/8$  میلی‌متر در یک جعبه فلزی با ابعاد  $40 \times 400 \times 400$  میلی‌متر تشکیل شده است. برای پرتاب موج سطحی از حلقه‌ای مسی دور تا دور محفوظه کوارتز استفاده می‌شود که ارتفاع و ضخامت آن به ترتیب ۲۵ میلی‌متر و ۲ میلی‌متر است و به فاصله ۴

پلاسمای سرد و ایزوتروپیک داخل محفظه دی‌الکتریکی از جنس کوارتز ( $\epsilon = 3.75$ ) قرار گرفته است و چگالی پلاسما، همانند آن‌چه در عمل واقعاً رخ می‌دهد، داخل ستون، از محل تحریک تا انتهای ستون، به صورت خطی تغییر می‌کند. فرض می‌کنیم پلاسما از قبل یونیزه شده است و به همین دلیل اثرات حالت گزرای برخورد موج الکترومغناطیسی با پلاسما [۱۵] را در نظر نمی‌گیریم. قابلیت گذردگی مختلط پلاسما به صورت زیر تعریف می‌شود:

$$\epsilon(\omega) = \epsilon_0 \left(1 - \frac{\omega_p^2}{\omega(\omega - jv)}\right) \quad (1)$$

که در آن  $\omega_p = 2\pi f_p = \sqrt{Ne^2 / m_e \epsilon_0}$  است و  $f_p$  فرکانس تشدید پلاسما (Hz)،  $N$  چگالی الکترون،  $v$  فرکانس برخورد (هرتز)،  $m_e$  جرم الکترون (کیلوگرم) و  $\epsilon_0$  قابلیت گذردگی فضای آزاد (فاراد بر متر) است.

در این تحلیل عددی، ترکیب معادلات ماکسول با یک معادله دیفرانسیلی که چگالی جریان را به شدت میدان الکتریکی مرتبط می‌سازد اساس روابط مورد نیاز را تشکیل می‌دهند. این روابط عبارتند از:

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial \vec{H}}{\partial t} \quad (2)$$

$$\nabla \times \vec{H} = \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} + \vec{J} \quad (3)$$

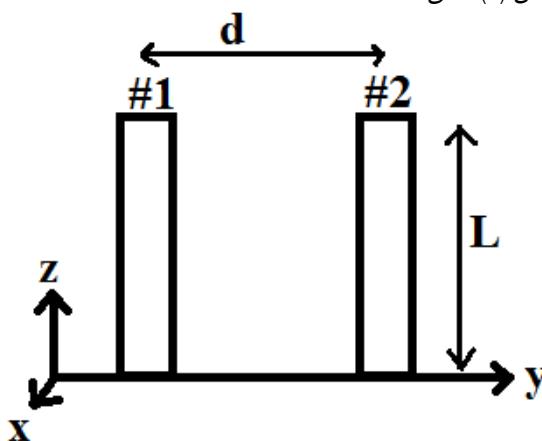
$$\frac{\partial \vec{J}}{\partial t} + \omega \vec{J} = \epsilon_0 \omega_p^2 \vec{E} \quad (4)$$

در روابط بالا،  $\vec{E}$  و  $\vec{H}$  به ترتیب میدان‌های الکتریکی (ولت بر متر) و مغناطیسی (آمپر بر متر) هستند،  $\mu_0$  قابلیت نفوذپذیری مغناطیسی فضای آزاد (هانری بر متر) و  $\vec{J}$  چگالی جریان پلاسما است. معادله (۴) بین معادلات ماکسول و چگالی جریان ارتباط برقرار می‌کند. برای تحلیل پلاسما به صورت عددی، پس از تقسیم ساختار مورد نظر به اجزای  $\Delta x$ ،  $\Delta y$  و  $\Delta z$  در گام‌های زمانی  $\Delta t$  معادلات را با استفاده از روش Yee<sup>۷</sup> و FDTD<sup>۸</sup> حل می‌کنیم. برای محاسبه میدان‌های تشعشعی دور از تبدیل میدان‌های دور به میدان‌های تزدیک روی مرز استفاده می‌شود [۱۶]. با استفاده از روش FDTD<sup>۹</sup> منابع جریان الکتریکی و مغناطیسی معادل آن‌ها روی سطح بسته هویگنس محاسبه شده و پس از محاسبه پتانسیل‌های برداری، میدان الکتریکی پراش یافته در میدان‌های دور در مختصات کروی محاسبه می‌شوند [۱۶–۱۸]. با استفاده از تحلیل به روش FDTD امپدانس ورودی آتن با تقسیم مقادیر ولتاژ محل تحریک به جریان آن در حوزه فرکانس قابل محاسبه است.

فرکانس‌های کاری مختلف و در شرایط فرکانس برخورد ۵۰۰ مگاهرتز در گاز آرگون که چگالی پلاسمای آن به صورت خطی تغییر می‌کند با نتایج حاصل شده از تحلیل به روش ممان [۲] مقایسه شده است و نتایج آن در شکل‌های الف-۲ و ب-۲ نشان داده شده است. این مقایسه بیانگر تطابق قبل قبول بین دو روش تحلیل است. قابل توجه است که نتایج تحلیل به روش ممان در [۲] با مقادیر اندازه‌گیری شده نیز مقایسه شده است.

### ساختار شبیه‌سازی شده

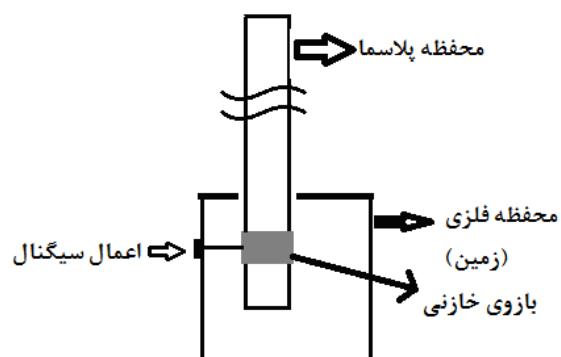
در کارهای پیشین، آتنن پلاسمای تکقطبی و نیز آرایه یاگی-اوای پلاسمایی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفتهند [۱۳ و ۵]. در این پژوهش، آرایه خطی با دو المان تکقطبی پلاسمایی مورد تحلیل قرار می‌گیرد در حالی که عده روابط همان روabilty است که برای کارهای پیشین بیان شد. ساختاری که مورد تحلیل قرار دادیم در شکل (۳) نشان داده شده است.



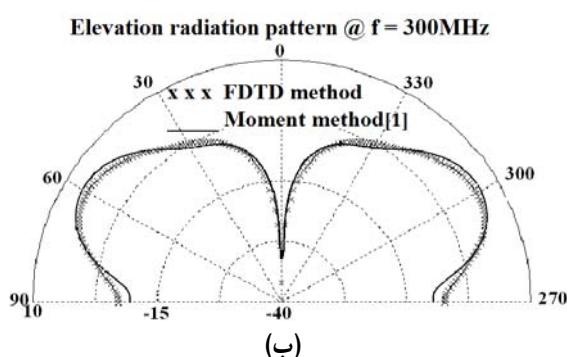
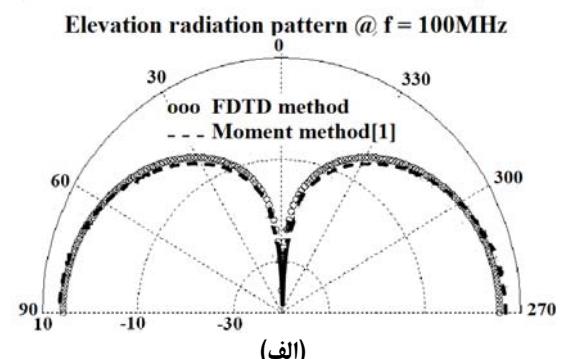
شکل ۳- ساختار شبیه‌سازی شده از آرایه خطی پلاسما

دو المان تکقطبی پلاسمایی #۱ و #۲ روی سطح زمین و به فاصله  $d$  از یکدیگر قرار گرفته‌اند. هر المان از یک محفظه کوارتز با شعاع ۱۲ میلی‌متر و طول ۱۲۰۰ میلی‌متر و ضخامت ۰/۵ میلی‌متر تشکیل شده است که با گاز آرگون با فشار ۴/۰ میلی‌بار پر می‌شود و لازم است با پرتاب موج سطحی تحریک شود تا یونیزه شود. برای اعمال سیگنال پیام نیز از ساختاری مشابه با ساختار پرتاب‌گر موج سطحی استفاده می‌شود. بنابراین، در شرایط آزمایشگاهی آتنن پلاسما نیاز به دو سیگنال متفاوت دارد. ساختار فنی آرایه پلاسمایی در شکل (۴) نشان داده شده است. مدارات تحریک از یک منبع سیگنال تشکیل می‌شود که توان آن در فرکانس حدود ۵۰۰ مگاهرتز تقویت می‌شود و با استفاده از یک تقسیم‌کننده توان مقدار توان آن بین دو آتنن به صورت مساوی تقسیم می‌شود. بخش مربوط اعمال سیگنال پیام نیز مشابه مدارات تحریک است.

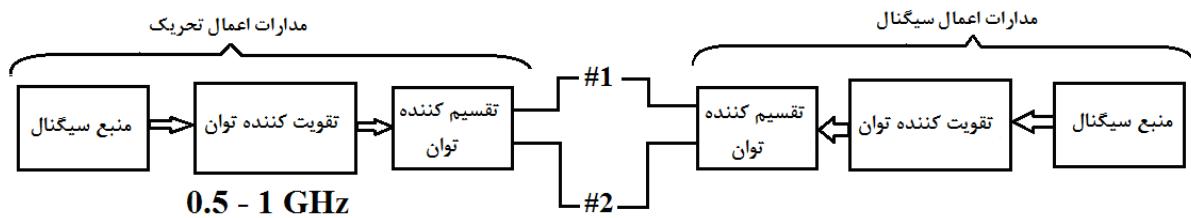
میلی‌متر پایین‌تر از ضلع بالایی جعبه فلزی قرار دارد. فرض می‌کنیم که محفظه کوارتز از پلاسمایی با فشار ۴۰ میلی‌بار پر شده است که معادل با فرکانس برخورد ۵۰۰ مگاهرتز است [۲]. آتنن پلاسما با اتصال مغزی کواکسیال به حلقه مسی و هادی بیرونی آن به جعبه فلزی تحریک می‌شود. حلقه مسی همانند بازوی خازنی سبب ایجاد میدان الکتریکی شدیدی میان حلقه و جعبه می‌شود و در نتیجه بیشتر خلطوط میدان تبدیل به موج سطحی شده و سبب تولید و حفظ پلاسما می‌شود.



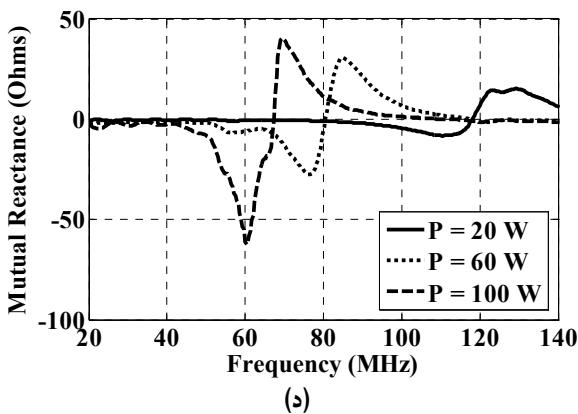
شکل ۱- ساختار آتنن پلاسما



شکل ۲- مقایسه الگوی تشعشعی محاسبه شده بهوسیله روش FDTD و مقایسه آن با نتایج بدست آمده در [۲] به روش ممان: (الف) ۱۰۰ مگاهرتز و (ب) ۳۰۰ مگاهرتز به منظور بررسی صحت نرم‌افزار فراهم شده برای تحلیل آتنن پلاسما، الگوی تشعشعی آتنن پلاسمای تکقطبی به طول ۱ متر در



شکل ۴- ساختار آرایه خطی از المان‌های تک‌قطبی پلاسمایی

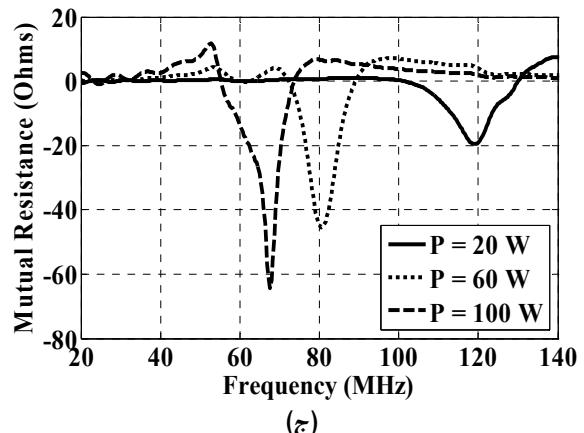
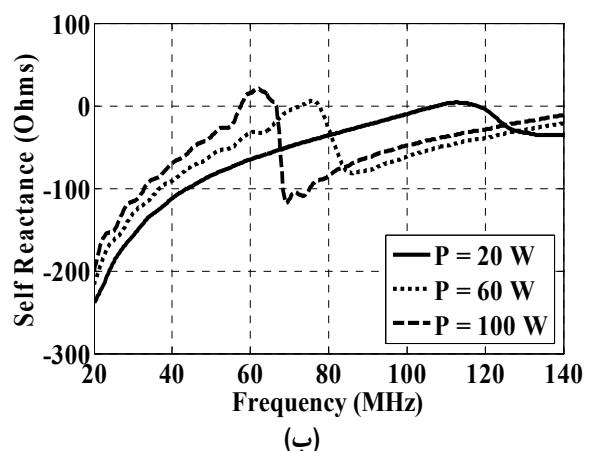
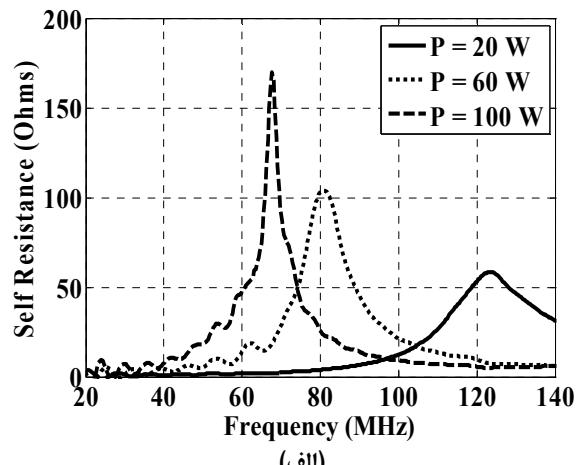


شکل ۵- تغییرات میزان امپدانس خودی و مقابله با تغییر توان تحریک در آرایه خطی پلاسمایی، (الف) قسمت حقیقی امپدانس خودی، (ب) قسمت موهومی امپدانس خودی، (ج) قسمت حقیقی امپدانس مقابله و (د) قسمت موهومی امپدانس مقابله

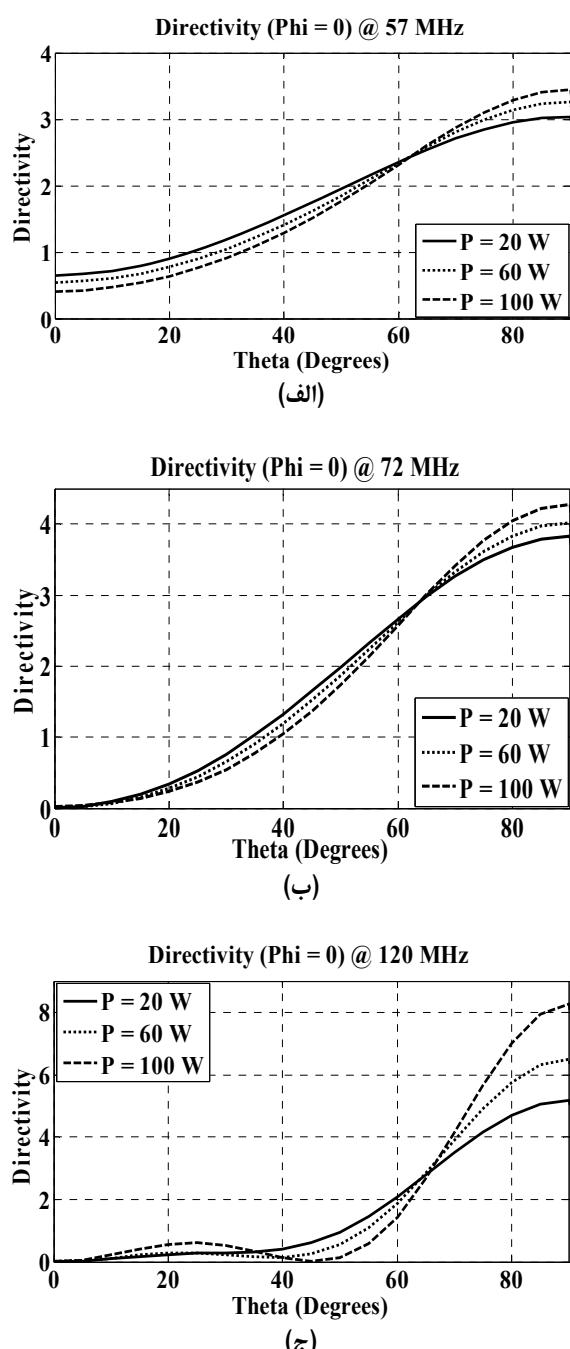
با توجه به آن که در این تحلیل، پلاسما یونیزه شده فرض شده و از تأثیرات حالت گذراي برخورد موج الکترومغناطیسي با پلاسما صرف نظر می‌شود، در شبیه‌سازی با روش عددی تنها ساختار پرتاپ موج سطحی برای اعمال سیگنال پیام درنظر گرفته می‌شود و فرض می‌شود که پلاسما از قبل یونیزه شده است. سپس با استفاده از رابطه (۵) چگالی پلاسما در طول ستون محاسبه می‌شود.

ساختار مورد نظر برای شبیه‌سازی را برای فرکانس مرکزی ۸۷ مگاهرتز، که معادل با طول موج  $\lambda = 3.4468$  متر است طراحی می‌کنیم. توان مورد نیاز برای حصول آتننی با ربع طول موج در این فرکانس، با توجه به معادلات (۵) تا (۸) برابر با ۶۰ وات است. فاصله بین دو المان نیز ربع طول موج، یعنی  $1.86$  میلی‌متر، درنظر گرفته شود.

تغییر توان تحریک در فشار گاز ثابت  $p = 0.04$  میلی‌بار و فرکانس تحریک ثابت  $f = 87$  مگاهرتز، با ثابت فرض کردن فاصله بین دو المان، سبب حصول آرایه پلاسمایی با قابلیت تغییر شکل می‌شود. در شکل (۵) تغییر میزان امپدانس خودی و مقابله آرایه مذکور با تغییر توان تحریک نشان داده شده است. افزایش توان تحریک



اختصاص دارد که با توان ۶۰ وات، توانی که آرایه بر حسب آن طراحی شده و فاصله بین دو المان ربع طول موج است، تحریک می‌شود. دلیل اصلی کم بودن راندمان در آرایه پلاسمایی، کوچک بودن مقدار قابلیت هدایت الکتریکی در ستون پلاسما نسبت به آرایه فلزی است. علاوه‌بر این، مقدار قابلیت هدایت در ستون پلاسما، متناسب با کاهش چگالی پلاسما در ستون، کاهش می‌یابد. با این وجود، برای حصول قابلیت‌های بالای استفاده از پلاسما به عنوان المان تشعشعی، ناگزیریم برخی رخدادهای نامطلوب، از جمله کاهش راندمان تشعشعی را بپذیریم.



سبب انتقال منحنی‌های امپدانسی از فرکانس‌های بالاتر به سمت فرکانس‌های پایین‌تر می‌شود. دلیل این انتقال افزایش طول آتن است که منجر به کاهش فرکانس تشید آن می‌شود. افزایش توان تحریک نه تنها سبب انتقال فرکانس کاری آرایه می‌شود، بلکه پهنهای باند امپدانسی را نیز کاهش داده و حدکثر مقدار امپدانس خودی و متقابل را نیز تغییر می‌دهد. بنابراین، با استفاده از المان‌های پلاسمایی، می‌توان آرایه خطی با قابلیت تغییر شکل مجدد به صورت دینامیک ایجاد کرد که در آن بهترین نقطه کاری آتن با تغییر توان تحریک و حداقل میزان تغییرات در عملکرد آن قابل حصول است. در جدول (۱) مقدار فرکانس تشید آرایه در صورت تحریک شدن با توان‌های مختلف نشان داده شده است و ستون انتهایی جدول بیانگر مقدار طول هر المان در هر حالت است.

جدول ۱- مشخصات آرایه با تغییر توان تحریک

فرکانس تشید (مگاهرتز)	توان تحریک هر المان (وات)	طول هر المان (میلی‌متر)
۱۱۶/۲	۲۰	۴۹۵
۸۵/۱۱	۴۰	۷۰۲/۵
۷۱/۹۵	۶۰	۸۶۱/۷
۵۷/۲۱	۱۰۰	۱۱۱۴/۱

در شکل (۶) تغییر میزان جهتداری آرایه در محدوده  $0 < \theta < 90^\circ$  در فرکانس‌های ۵۷ مگاهرتز، ۷۲ مگاهرتز، ۱۲۰ مگاهرتز و ۲۰۰ مگاهرتز در صفحه  $\varphi = 0$  نشان داده شده است. در فرکانس‌های کاری کمتر از ۱۲۰ مگاهرتز، افزایش توان تحریک سبب افزایش میزان جهتداری و نیز باریکتر شدن پرتو در جهت جانبی<sup>۱</sup> می‌شود. این در حالی است که در فرکانس‌های کاری بالاتر از ۱۲۰ مگاهرتز، همان‌گونه که در شکل (۶-ب) نشان داده شده است، سبب افزایش تعداد لوبهای فرعی و نیز کاهش مقدار جهتداری آتن می‌شود. در محدوده فرکانس کاری بین ۴۰ مگاهرتز تا ۱۴۰ مگاهرتز، حدکثر مقدار بهره و جهتداری به آرایه‌ای اختصاص دارد که با حدکثر توان، یعنی ۱۰۰ وات، تحریک می‌شود.

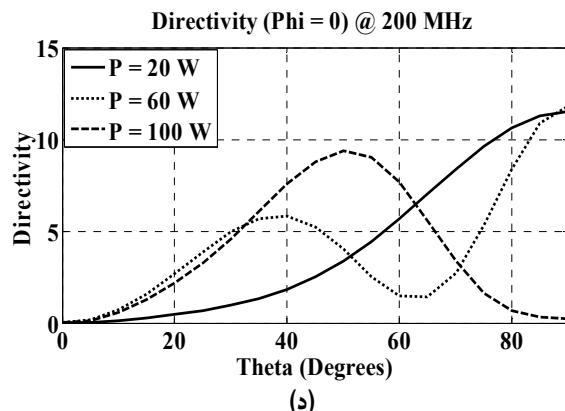
از آن‌جا که راندمان آتن در سیستم‌های مخابراتی اهمیت بالایی دارد، راندمان آرایه پلاسمایی در محدوده حداقل و حدکثر توان تحریک مورد تحلیل قرار گرفته است و نتایج آن در شکل (۶-ب) نشان داده شده است. نکته جالب در آن است که تغییر توان تحریک سبب می‌شود راندمان تشعشعی آرایه در فرکانس تشید جدید تقریباً ثابت (کمتر از ۷۰%) باشد؛ حال آن که حدکثر مقدار راندمان به آرایه‌ای

1. Broadside

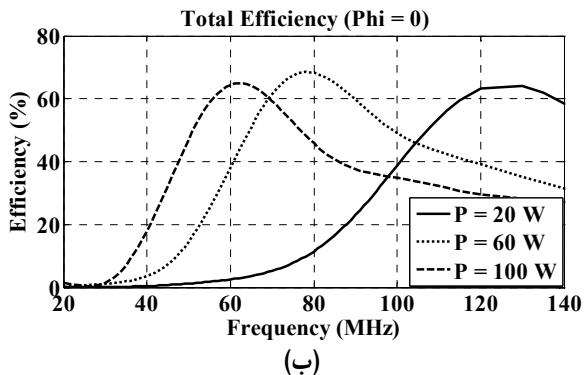
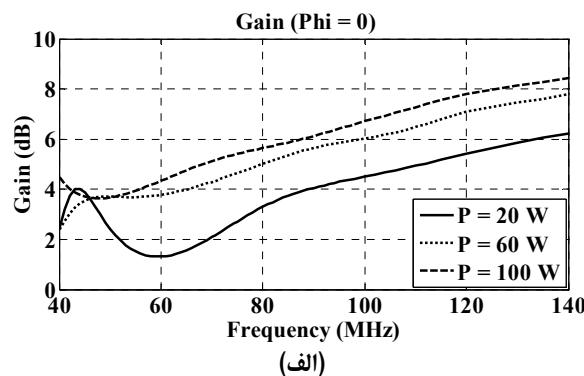
FDTD نشان داده شد که تغییرات توان تحریک المان‌های پلاسمایی سبب تغییر فرکانس تشیدی آرایه می‌شود در حالی که مقدار بهره و راندمان تشعشعی آن، در فرکانس تشیدی جدید، تقریباً بدون تغییر باقی می‌ماند. برخورداری از این قابلیت انعطاف بالا، هرچند به قیمت کاهش راندمان تشعشعی نسبت به آتن فلزی می‌شود، می‌تواند توانمندی چشمگیری در تحقق سیستم‌های مخابراتی و اجتناب از تداخل فرستندها و گیرندهای روی بدنه محموله داشته باشد.

## مراجع

- [1] Fujimoto, K., *Mobile Antenna Systems Handbook*, Artech House, June, 2008.
- [2] Rayner, J. P., Witchello, A. P. and Cheetham, A. D., "Physical Characteristics of Plasma Antennas," *IEEE Transaction on Plasma Science*, Vol. 32, No. 1, February, 2004, pp. 269-281.
- [3] Kumar, R. and Bora, D., "A Reconfigurable Plasma Antenna," *Journal of Applied Physics*, Vol. 107, No.5, 2010, pp. 053303-1-053303-9.
- [4] Kumar, R. and Bora, D. "Wireless Communication Capability of a Reconfigurable Plasma Antenna," *Journal of Applied Physics*, Vol. 109, No.6, 2011, pp. 063303-1 - 063303-9.
- [5] Sadeghikia, F., Hodjat-Kashani, F., Rashed-Mohassel, J., and Ghayoomeh-Bozorgi, J., "Characterization of a Surface Wave Driven Plasma Monopole Antenna," *Journal of Electromagnetic Waves and Applications*, Vol. 26, No. 2-3, 2012, pp. 239-250.
- [6] Cerri, G., Leo, R. D., Primiani, V. M., and Russo, P., "Measurement of The Properties of a Plasma Column Used as a Radiating Element," *IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement*, Vol. 57, No. 2, 2008, pp. 242-247.
- [7] Moisan, M. and Zakrzewski, Z., "Plasma Sources Based on the Propagation of Electromagnetic Surface Waves," *Journal of Physicsics. D: Applied Physics*, Vol. 24, No.7 , 1991, pp. 1025-1048.
- [8] Borg, G.G., Harris, J. H., Miljak, D. G., Martin, N. M., "Application of Plasma Columns to Radio frequency Antennas", *Applied Physics Letters*, Vol. 74, No. 22, 1999, pp. 3272-3274.
- [9] Borg, G. G., Harris, J. H., Martin, N. M., Thorncraft, D., Milliken, R., Miljak, D. G., Kwan, B., Ng, T. and Kircher, J., "Plasmas as Antennas: Theory, Experiment and Applications", *Physics of Plasmas*, Vol. 7, No. 5, May 2000, pp. 2198-2202.
- [10] Cerri G., Leo R. D., Primiani V. M., and Russo P., "Measurement of The Properties of a Plasma Column Used as a Radiating Element," *IEEE Transaction on Instrumentation and Measurement*, Vol. 57, No. 2, 2008, pp. 242-247.
- [11] Anderson, T., Alexeff, I., Farshi, E. and Karnam N., "An Operating Intelligent Plasma Antenna," *16<sup>th</sup> IEEE International Conference on Pulsed Power*, Albuquerque, New Mexico USA, Vol. 1, No. 1, June, 2000, pp. 353-356.



شکل ۶- تغییر میزان جهت‌داری آرایه خطی پلاسمایی با تغییر توان تحریک (الف) فرکانس ۵۷ مگاهرتز و (ب) ۷۲ مگاهرتز (ج) ۱۲۰ مگاهرتز و (د) ۲۰۰ مگاهرتز.



شکل ۷- اثرات تغییر توان تحریک در آرایه خطی پلاسمایی بر (الف) بهره آتن پلاسمایی و (ب) راندمان تشعشعی آتن پلاسمایی در محدوده فرکانسی کمتر از ۱۴۰ مگاهرتز.

## نتیجه‌گیری

به منظور استفاده چندمنظوره از آتنی که روی وسیله نقلیه هوایی و فضایی نصب می‌شود، آرایه خطی پلاسمایی پیشنهاد و مورد تحلیل قرار گرفت. هدف از این طرح، پیشنهاد روشی برای کاهش تعداد آتن‌ها روی بدنه این سامانه‌هاست. با استفاده از تحلیل به روش

- [17] Taflove, A., *Computational Electromagnetics: The Finite Difference Time Domain Method*, Artech House, Boston, FL, 1995.
- [18] Luebbers, R. J., Kunz, K. S., Schneider, M. and Hansberger, F., "A Finite Difference Time Domain Near to Far Zone Transformation," *IEEE Transaction on Antennas and Propagation*, Vol. 39, No. 4, April, 1991, pp. 429-433.
- [19] Naz, M. Y. and Ghaffar, A., Rehman, N. U., Naseer, S. and Zakaullah, M., "Double and Triple Langmuir Probes Measurements in Inductively Coupled Nitrogen Plasma," *Progress In Electromagnetics Research*, Vol. 114, 2011, pp.113-128.
- [20] Naz, M. Y., Ghaffar, A., Rehman, N. U., Azam, M., Shukrullah, S. and Qayyum, A., "Symmetric and Asymmetric Double Langmuir Probes Characterization of Radio Frequency Inductively Coupled Nitrogen Plasma," *Progress In Electromagnetics Research*, Vol. 115, 2011, pp.207-221.
- [12] Popov Oleg, A., *High Density Plasma Sources: Design, Physics and Performance*, Noyes publication, Park Ridge, New Jersey, 1995.
- [13] Sadeghikia, F., Hodjat-Kashani, F., Rashed-Mohassel, J., and Ghayoomeh-Bozorgi, J., "A Yagi-Uda Plasma Monopole Array," *Journal of Electromagnetic Waves and Applications*, Vol. 25, No. 7, 2012, pp. 885-894.
- [14] Nickisch, L. J., and Franke, P. M., "Finite Difference Time Domain Solution of Maxwell's Equations For the Dispersive Ionosphere," *IEEE Antennas and Propagation Magazine*, Vol. 34, No. 5, 1992, pp. 33-39.
- [15] Russo, P., Cerri, G., and Vecchioni, E., "Self-Consistent Analysis of Cylindrical Plasma Antennas," *IEEE Transaction on Antennas and Propagation*, Vol. 59, No. 5, 2011, pp. 1503-1511.
- [16] Kunz, K. S. and Luebbers, R. J., *The Finite Difference Time Domain Method For Electromagnetics*, CRC press, Boca Raton, FL, 1993.